

5 Como el potencial es periódico, puedo escribir una serie de Fourier:

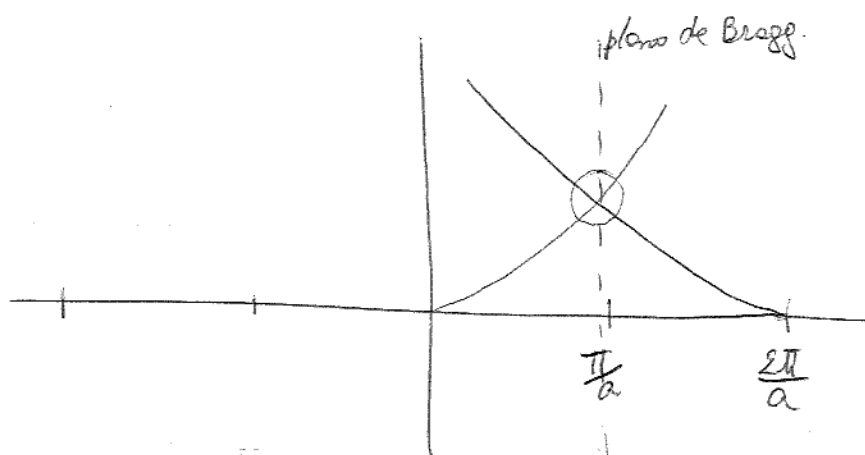
$$U_k = \sum \dots \quad V(x) = \sum e^{iKx} \cdot V_k$$

donde: $K = \frac{2\pi n}{a} \quad n \in \mathbb{Z}$.

$$V_k = \frac{1}{a} \int_{-a/2}^{a/2} V(x) e^{-iKx} dx = \frac{1}{a} \int a V_0 \delta(x) e^{-iKx} dx$$

$$V_k = V_0$$

Sabemos de la teoría, que la influencia mayor del potencial estará dada en los planos de Bragg:



Uso:
$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} (k - k')^2 - \epsilon \right] C_{k-k} + \sum_{k'} V_{k'-k} C_{k-k'} = 0$$

que en nuestro caso se reduce a:

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} (k-K)^2 - \epsilon \right] C_{k-K} + V_0 \sum_{K' \neq K} C_{k-K'} = 0$$

↑ por renormaliz. del potencial $V_0=0$

Tomamos las bandas $K=0$ y $K=2\pi/a$ en $k=\frac{\pi}{a}$,
 pues ambos tienen $\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{a} - \frac{2\pi}{a}\right)^2$

mismo energía.

$$\begin{cases} \left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 - \epsilon \right] C_k + V_0 C_{k-K} = 0 \\ \left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 - \epsilon \right] C_{K-K} + V_0 C_k = 0 \end{cases}$$

← solo aquellos del subespacio degenerado

$$\begin{vmatrix} \epsilon_0 - \epsilon & V_0 \\ V_0 & \epsilon^{(0)} - \epsilon \end{vmatrix} = 0$$

$$(\epsilon_0 - \epsilon)^2 = V_0^2 \rightarrow$$

$$\boxed{\epsilon = \epsilon_0 \pm V_0}$$

↑
gap.

SOLO ENCONTRE EL GAP, pues para ver como cambia la energía con k , tengo que estudiar $\left[\frac{\hbar^2}{2m} (k-K)^2 - \epsilon \right] C_k \dots$

¿Es el sistema aislante o conductor?

Para contestar esta pregunta determinamos qué sucede cuando cada sitio aporta 1 o 2 e^- .

En una "esfera" (estamos en 1D), de Fermi de radio k_F quiero alojar N_e electrones (MODELO DE ELECTRON LIBRE):

$$N_e = 2 \times \frac{2k_F}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)} = \frac{2}{\pi} \times k_F \times (a \times N)$$

↑ spin
↑ discretización
↑ parámetro de red
↑ # de sitios

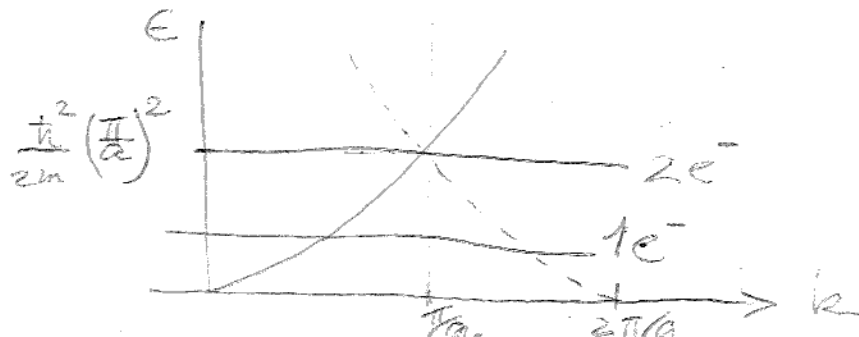
y tenemos $N_e = \mu \times N$

↑ # de e^- aportados por sitio

$$\therefore k_F = \frac{\pi}{2} \mu N \frac{1}{aN} = \frac{\pi \mu}{2a}$$

Notar que, para $\mu = 2$, $k_F = \frac{\pi}{a}$, que es el límite de la 1BZ.

En términos de la $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\pi^2 \mu^2}{4a^2}$



Ya vimos que, por el potencial, apareció un gap en $\frac{\pi}{a}$. Cuidadoso sea el valor de V_0 , si tengo $2e^-/\text{sitio}$, el sistema será aislante, pues los e^- ocuparán la 1ª banda completamente y para pasar a la siguiente necesitarán de una cantidad grande (el gap) de energía.

Si el sistema aporta $1e^-/\text{sitio}$ el V_0 debe ser lo suficientemente grande para llegar a la $E_F(1e^-)$.

— — —
 - Calculemos la densidad de estados (DOS). Existen diferentes maneras, veremos dos.

1) Como en prácticas anteriores:

$$2 \sum_{\uparrow \downarrow} \dots \rightarrow 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{\Delta k}$$

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L}$$

$$dk = \frac{dk}{dE} dE, \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad \frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{m}$$

$$dk = \frac{m}{\hbar^2 k} dE = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} dE$$

95/5

juntando todo:

$$2 \int_0^{\infty} \frac{2 \times \left(\frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} dE \right)}{\left(\frac{2\pi}{L} \right)}$$

en $g(E)$ la "L" no va, pues uno estudia densidades: ej: $n = \frac{N}{L}$

$$g(E) = \frac{2}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}$$

Otro método:

2) Contemos estados k con energía E :

$$g_n(E) = \int_{BZ} \frac{dk}{\pi} \delta[E - E_n(k)]$$

$$\delta[\] = \sum_{k_0} \frac{\delta(k - k_0)}{\left| \frac{d}{dk} [E - E_n(k)] \right|_{k_0}}$$

donde k_0 hace que el argumento se anule:

$$\frac{d}{dk} (E - E_n) = -\hbar^2 k / m \quad k_0 / E - \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} = 0$$

$$k_0 = \pm \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad \delta(E - E_n) = \frac{\delta(k - |k_0|)}{\frac{\hbar^2 |k_0|}{m}} + \frac{\delta(k + |k_0|)}{\frac{\hbar^2 |k_0|}{m}}$$

$$\frac{\hbar^2 |k_0|}{m} = \frac{\hbar}{m} \sqrt{2mE} = \hbar \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

$$g_1(\epsilon) = \frac{2}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2\epsilon}}$$

